

실험 11 공통소오스 증폭기

- 이름 :
- 실험일 :

시뮬레이션 11-1 | N-채널 MOSFET 공통소오스 증폭기 해석하기

표 11-1 N-채널 MOSFET 공통소오스 증폭기의 시뮬레이션 결과

동작점 전류, 전압 (시뮬레이션 결과)	$V_{GSQ}$ [V]	
	$I_{DQ}$ [mA]	
	$V_{DSQ}$ [V]	
전달컨덕턴스 계산 (시뮬레이션 결과)	$g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{Tn}}$ [mA/V] $V_{Tn}$ 은 실험 09의 시뮬레이션 결과 값을 사용	
$v_s$ 의 첨두-첨두값 [V] (시뮬레이션 입력)		
$v_s$ 와 $v_o$ 의 위상 관계		
$R_L$ [k $\Omega$ ]	$v_o$ 의 첨두-첨두값 [V] (시뮬레이션 결과)	
0.150		
0.200		
0.270		
0.430		
0.510		
0.620		
0.820		

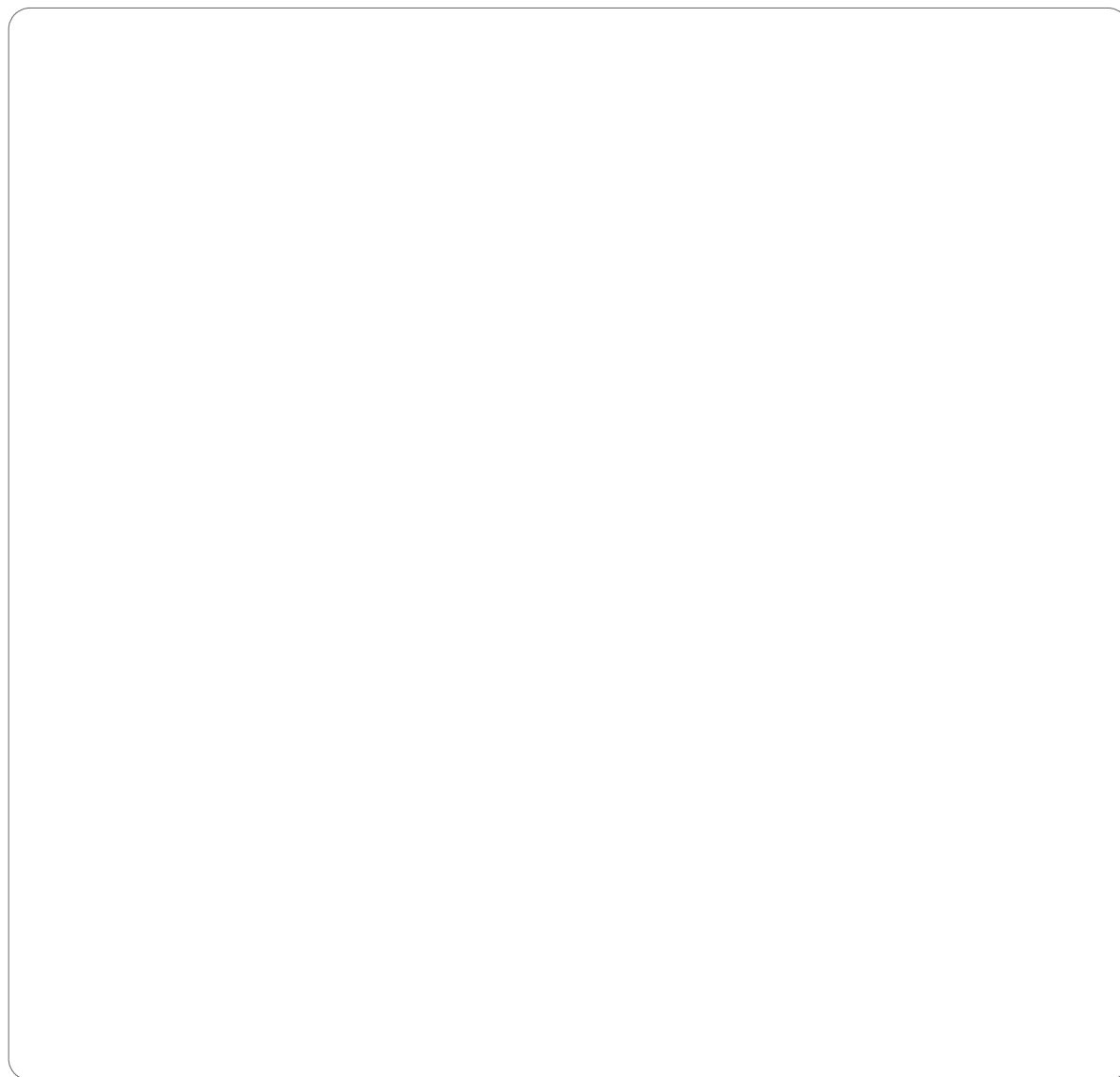


그림 11-4 N-채널 MOSFET 공통소오스 증폭기의 시뮬레이션 결과 파형

## 시뮬레이션 회로

### ■ 시뮬레이션 11-1-1 회로



### ■ 시뮬레이션 11-1-2 회로

